PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

._____

(11) Publication number: 04-017139

(43) Date of publication of application: 21.01.1992

(51) Int.CI. G11B 11/10 G11B 7/24

(21) Application number: 02-119991

(71) Applicant: TEIJIN LTD(22) Date of filing: 11.05.1990

(72) Inventor: SEKIYA MASAHIKO

HONJO KAZUHIKO

(54) OPTICAL RECORDING MEDIUM

(57) Abstract:

PURPOSE: To enable recording of whole area from the inner circumference area to the outer circumference area with constant recording power and good C/N by controlling the film thickness of an org. protective layer in the radial direction so as to control the recording sensitivity of the whole recording area to a certain range.

CONSTITUTION: Film thickness of an org. protective layer is controlled in the radial direction so as to control the recording sensitivity of the whole recording area in a certain range. The org. protective layer 6 has such a structure that gives the recording sensitivity of the recording area in the range with which recording/reproducing of high C/N can be realized with a constant laser power. This structure is obtained by controlling the film thickness of the protective layer 6 so that the inner circumference area has larger thickness and gives higher thermal radiation than the outer circumference area. Thus, recording can be performed in the whole area from the inner circumference area to the outer circumference area with constant recording power, and reproducing C/N can be improved.

⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

平4-17139 ◎公開特許公報(A)

®Int. Cl. 5

強別配号

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)1月21日

G 11 B 11/10

9075-5D 7215-5D A B

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全6頁)

光記録媒体 60発明の名称

> 頤 平2-119991 20特

頭 平2(1990)5月11日 包出

昌 彦 谷 @発明 者 関

東京都日野市旭が丘4丁目3番2号 帝人株式会社東京研

究センター内

彦 和 本 Æ 者 @発 明

東京都日野市旭が丘4丁目3番2号 帝人株式会社東京研

究センター内

帝人株式会社 人 勿出 頭 弁理士 白井 重隆 四代 理 人

大阪府大阪市中央区南本町1丁目6番7号

137

1. 発明の名称 光記録媒体

2. 特許請求の範囲

(1)円盤状基板上に、光記録階および有機保護層を 備えた光記録媒体において、該有機保護層の膜厚 を半径方向で調整して記錄領域全面の記録感度を 一定範囲に調整したことを特徴とする光記録媒体。 (2)前記有機保護層が光記録層側の第1層と第1層 の上に積層された第2層とで構成され、第1層の 膜厚は一定で、第2層により有機保護層全体の膜 厚が調整された請求項1記載の光記録媒体。

(3)有機保護層の内間部のみ一定厚みだけ膜厚が厚 い請求項1または2記載の光記録媒体。

(4) 第2層が内周部のみに設けられている請求項2 または3記載の光記録媒体。

(5)有機保護層がUV硬化膜からなる請求項1~4 のいずれか1項記載の光記録媒体。

3. 発明の詳細な説明 (産業上の利用分野)

本発明は、レーザー光を用いて情報の記録再生 消去を行う光記録媒体に関する。

(従来の技術)

光記録媒体は、高密度・大容量の情報記録媒体 として種々の研究開発が行われている。特に、情 報の消去可能な光磁気記録媒体は、応用分野が広 く種々の材料・システムが発表されており、その 実用化が待望されている。従来より知られている 光磁気記録媒体の構成は、基板としてガラスある いは有機物樹脂を用い、基板上に基板面に対して 垂直方向に磁化を有する垂直磁化膜からなる光磁 気記録暦を形成したものである。光磁気記録層と しては、例えばTbFe、TbGdFe、

TbFeCo、DyFeCo、NdFeなどすで に多くの提案がある。しかし、これらの情報の消 去可能な光磁気記録媒体の実用化には、記録、再 生特性のより一層の向上が必要である。

これに対して、光磁気記録層上、もしくはその 上に誘電体層を介して金属反射層を設ける方法が 提案されている。この方式は、カー効果とファラ デー効果の併用により高いC/Nを得る点で優れている。

しかしながら、従来より知られている光磁気配録媒体では、等角速度で媒体を回転して情報の記録・再生・消去を行う場合、半径位置に応じて線速度が変わるため、記録パワー、再生パワー、消去パワーを変えなければならないという欠点があった。

この問題を解決するため、金属反射層の膜厚を 半径方向に変化させた光磁気記録媒体が提案され ている(特開図61-211852号公報参照)。

ところが、この構成では、その感度を均一化するための金属反射形の中央部の膜厚が数

1.000 A と大きくなり、生産面で不利となる とともに金属反射層の内部応力などにより媒体歪 み、層剝離など機械的特性面、耐久性面でも問題 がある。

(発明が解決しようとする課題)

本発明は、かかる現状に鑑みなされたもので、 前紀問題がなく、内間部から外周部まで同一記録 パワーでC/Nも良く記録できる光記録媒体の提供を目的とする。

(課題を解決するための手段)

本発明は、円盤状基板上に、光記録層および有機保護層を備えた光記録媒体において、練有機保護層を備えた光記録媒体において、練有機保護圏の限算を半径方向で調整して記録領域全面の記録感度を一定範囲に調整したことを特徴とする 光記録媒体である。

光記録媒体は、一般に機械的保護、耐久性の向上をはかるため、記録層あるいは金属反射層また はこれらの上の無機保護層の上に有機保護層を積 層されているのが一般的である。

ところで、本発明者らは、光記録媒体の検討の 過程でこの有機保護層の形成により光記録媒体の 記録感度が大きく低下することを見出した。

本発明は、かかる知見に基づいてなされたものである。

すなわち、本発明は、この有機保護層の膜厚を 半径方向で調整して記録領域全面の記録感度を一 定衡用に調整した光記録媒体である。本発明にお

3

いては、金属反射層などは従来とおりで、生産性が良く、膜の内部応力の調整が容易な有機保護層の腰厚を調整することにより記録感度を調整するので、前述の問題のない記録領域の記録感度が所定範囲にある光記録媒体が実現される。

本発明の有機保護層の構成は、記録領域の記録 感度を同一レーザーパワーでC/Nも充分高い記録・再生ができる範囲にするようにその膜厚を調整したものであれば良く、具体的には内周部が外 周部より熱放射の良い膜厚の厚い構成である。

生産性面などから2層構成が好ましく、なかでも、記録層側の第1層の厚みは一定で第2層が内 顔部のみに設けられた構成が好ましい。

有機保護層の内閣部の膜厚のみを厚くすることにより、光記録媒体の内閣部の熟放散が大きくなり、回転速度一定方式で内閣部から外閣部まで同一記録パワーで再生のC/Nも良く記録できる。

本発明の有機保護層の材料としては特に限定されるものでなく、公知の光および熱硬化型樹脂あるいは熱可塑性樹脂などが使用できる。ただし、

生産面からUV硬化樹脂が好ましく使用される。

前記UV硬化樹脂としては、耐久性の頃からフェノールノボラックエボキシアクリレート、ウレタンアクリレートなどを挙げることができる。

本発明の有機保護層の膜厚は、耐久性面、全体の怒度面、膜応力などから、用いる材料に応じて実験的に決める必要があるが、通常は1~100μmの範囲で選定される。内周部のみに第2層を設ける場合の第2層の膜厚は、第1層の膜厚および第2層の熱伝導などとの関係から実験的に決める必要があるが、通常は1~50μmの範囲で選定される。

以上の本発明は、公知のコンパクトディスク、 追記型光ディスクあるいは光磁気ディスク、相変 化型ディスクなどの音き替え可能型光ディスクな どの光記録媒体全てに適用できる。なかでも、コ ンピューターの補助メモリーとして実用化が進み つつあり、データ転送速度の向上などが要望され ている光磁気ディスクに効果的である。かかる光 硫気ディスクとしては、以下の構成のものが挙げ

c

られる.

基板の材料としては、ポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、エボキシ樹脂、4ーメチルーペンテン樹脂など、もしくはそれらの共低合体などの高分子樹脂、またはガラスなどが適用できる。

なかでも、機械的強度、耐候性、耐熱性、透湿性の点でポリカーボネート樹脂が好ましい。

光記録暦としては、光熱磁気効果により記録・再生できるものであれば良く、具体的には膜固に 垂直な方向に砒化容易方向を有し、任意の反転磁 区を作ることにより光磁気効果に基づいて情報の 記録・再生が可能な磁性金属薄膜、例えば TbFe、TbFeCo、GdTbFe、 GdFeCo、NdDyFeCo、 NdDyTbFeCo、NdFe、PrFe、 CeFeなどの希土類元素と遷移金属元素との非 格子多層膜などに適用できる。

さらに、前記光磁気記録層として、組成の異なる複数の光磁気記録層を積層したものについても

適用可能である。このような複数の光磁気配録層を用いる場合には、読み出し性能の高い層と記録 感度の高い層とを積層することにより、C/Nが高く記録感度の高い媒体が実現でき、特に高速回 転時への応用の際には有効となる。

光磁気記録層の膜厚は、100~2,000 A が好ましく、150~800 Aがさらに好ましい。なお、金属反射層と組合わせる場合は、200~600 Aが好ましい。

本発明における光磁気記録媒体の積層構成は、 特に限定されないが、金属反射層を光磁気記録層 の光入射面と反対側に形成した構成がC/N、耐 久性の面より好ましい。なかでも、金属反射層と 光磁気記録層間に透明講覧体層を設ける構成は、 記録感度、C/N、耐久性の向上面より好ましい。

さらに、基板と光磁気記録層間にも誘電体層を 設けた構成、つまり光磁気記録層を透明誘電体層 で挟んだ構成は、一層のC/N向上、透湿防止な どの効果による耐久性が得られさらに好ましい。

ところで前記金属反射層は、ALAuまたは

8

7

AgAu合金、特にAlAuTi合金またはAg AuTi合金からなる金属反射層とすることが好ましい。

A & A u Ti合金またはA g A u Ti合金は、 熱伝導率が比較的低く、これを金属反射層として 用いることにより、ディスク回転数が高い場合、 例えばISO規格案の倍速、具体的に3,600 r P m の場合においても熱の鉱散を防止でき、全 体の配録感度が高くなり、内間部から外間部まで 10m w 以下の小さい同一記録パワーでさ再生の C / N レベルも充分な配録ができ、高速転送に好 遺な媒体が実現される。

前記A L A u T i 合金またはA g A u T i 合金のおいてA u の添加量は、0.5~20.0原子%が好ましく、0.5~15.0原子%がさらに好ましく、0.5~10.0原子%が特に好ましい。また、T i の添加量は、0.3~5.0原子%が好ましい。

- 金属反射膜の膜厚は、1_0_0<u>~5,_0_0_0人、</u> さらには400~2.000人が好ましい。 前記A & A u 合金またはA g A u 合金は、前記 のとおり熱伝導率が比較的小さいので、金属反射 層を光磁気記録層上に直接接して設けた簡単な構成でも使用できる。また、一方、金属反射層上に 透明誘電体などの無機保護層を設けて耐久性向上

を計ったものも適用でき、目的に応じて種々の横

成をとることができる。

前記機成に用いる基板側、金属反射層側の両透明器電体層としては、その目的により光干渉効果、カー効果エンハンスメントなどの効果を奏することが必要で、ある程度以上の高圧折率、すなわち
1.8以上、さらに好ましくは2.0以上を有することが好ましい。また、使用するレーザー光に透明であることが必要であり、透明誘電体としてはALN、MgFz、ZnS、CeFa、ALFa・3NaF、SinN。ALSiN、SiO、SiOz、ZrzOz、InzOz、SnOz、TazOz、ALON、SiON、ZrON、InON、SnON、TaONまたはこれらの混合体などが適用できる。特に、屈折率

1 0

が2.0以上という点では、ALSiN、ZnS、 Zr.〇,、Ta.〇,、ZrON、TaONが 好ましい。

透明誘電体の膜厚は、媒体 成、屈折率により 設適値が変化するため一義的には決めることはで きないが、通常は基板と光磁気配録層との間の透 明誘電体膜厚が500~1,500人程度、光磁 気記録層と金属反射層との間の透明誘電体膜厚が 100~1,000人が好適に用いられる。

また、前記無機保護暦としては、金属膜と誘電体膜が挙げられる。

金属膜は、それ自身の耐久性が充分高く、かつ 媒体の記録窓度を低下させないために熱伝導率が 低いことが必要である。そのような特性を有する 金属であれば特に限定する必要はないが、な合金 あTi、Cr、Ni、Reおよびこれらの合金か らなる金属膜は特に好ましい。なお、金属膜の膜 は、前記諸点より100~5,000人が好ま しく、さらに好ましくは400~2,000人で ある。

1 1

めに、特に高分子基板との密着性が大きい条件で 作製することが好ましい。このためには、スパッ タリング法が好ましい。

以上、本発明の光記録媒体は、前記構成のままで、さらに保護平板、保護フィルムなど必要な保護を付加して片面記録媒体として、あるいはその2枚を金属層側で貼り合わせた両面記録媒体として使用される。

(家排例)

以下、実施例を挙げて本発明をさらに詳細に説明する。

実施例1~2

以下のようにして基板上に第1図に示す構成の 光磁気記録媒体を作製し評価した。

第1図においては、1は基板、2は透明誘電体 層、3a、3bは第1、第2の光磁気配録層、4 は裏面透明誘電体層、5は金属反射層、6aおよ び6bは有機保護層である。

直径130m、厚さ1.2mの円盤で1.6 μmピッチのグループを有するポリカーボネート 一方、誘電体膜は、熱伝導率が低く、腹厚が厚くても記録特性への影響が小さく、充分な保護ができる点で優れている。かかる誘電体がそのまむエンハンス層として公知の透明誘電体がそのまま適用できるが、特に耐透湿性もよいという点で変化アルミニウム、変化シリコンを化物膜、酸化シリコン・酸化物膜が好ましく、なかでも窒化物膜が好ましく、なかでも窒化物膜が好ましい。誘電体膜の膜が破壊が関係しない点で好ましい。誘電体膜の膜厚は、100~5.000人、好ましくは200~2.000人が好適に用いられる。

本発明の有機保護層の形成方法としては、例えばスピンコート法、ロールコート法、スクリーン 印刷法など公知の堕布方法が適用できる。

また、前記光磁気記録層、誘電体層、金属反射 用および無機保護層の形成方法としては、公知の 真空療者法、スパッタリング法などのPVD法、 あるいはCVD法など、種々の薄膜形成法が通用 できる。しかし、光磁気記録媒体としては、高温 高温耐環境性試験で生じる剝離を生じさせないた

1 2

樹脂 (PC) 製デイスク基板 1 を、 3 ターゲット の高周波マグネトロンスパッタ装置 (アネルバ戦) 製、 SPF-4 3 0 H型) の真空槽内に固定し、 4×10-7 or rになるまで排気した。

なお、膜形成において、基板1は、15 r p m で回転させた。

まず、透明誘電体層2として、ターゲットとしては、直径100m、厚さ5mの円盤で、Alse(以下添数字は組成(原子%)を示す)の焼結体を用い、真空槽内にAr/Nェ混合ガス(Nェ30vol%)を導入し、圧力5mTorrになるようにAr/Nェ混合ガス流量を調整した。放電電力100w:放電周波数13.56MHzで高周波スパッタリングを行い、誘電体層2としてAleoSieoNzo透明誘電体層を1,200人堆積させた。

次に、光磁気配録暦3aとして、ターゲットを GdilFessCoss合金ターゲットの円盤に代え、 スパッタリングガスを純Ar(5N)とする以外 は前配と同様の放電条件でGds.FessCoss合 金融を約150人堆積させた。

· • · · · · · ·

続いて、光磁気記録層3bとして、ターゲットをTbェェFe・ェCo。合金ターゲットの円盤に代え、前記と同様の放電条件でTbェェFe・ェCo。合金牌を約200人推稿させた。

さらに、裏面保護層4として、ターゲットを A&Siに戻しスパッタリングガスをAr/N: 混合ガス(N:30vo&%)に代え、前記と同様の放電条件でA&。SiaoN:o透明誘電体層を 350人堆積させた。

金属反射層 5 として、ターゲットをA & もしくはA g の円盤上にA u およびT i のチップを (5 × 5 × 1 mm t) を適当数配置したものとし、スパッタリングガスをA r に代え、前記と同様の放電条件で金属反射層 5 としてA & * i A u * T i * (実施例 1) もしくはA g * i A u * T i * (実施例 2) を 6 0 0 A 於けた。

この積層体をスパッタリング装置から取り出し、 スピンコーターに取りつけた。ディスクを回転さ せながら紫外線硬化性のフェノールノボラックエ

1 5

0.76μm、60mRで1.52μmのピットが記録される条件で行った。なお、記録・消去の際の印加磁界は、2500e(エルステッド)である。各媒体の最適記録レーザーパワーおよびC/Nを第1表に示す。

比較例1~2

以下のようにして基板上に第2図に示す構成の 光磁気配録媒体を作製し評価した。

第2図において、1は基板、2は透明誘電体層、3 a、3 bは第1、第2の光磁気配録層、4 は裏面透明誘電体層、5 は金属反射層、6 は有機保護層である。

各媒体の最適記録レーザーパワーおよびC/N

ボキシアクリレート樹脂を譲布したのち、紫外線 照射装置を通過させて樹脂を硬化させ、約20 μmの有機保護層の第1層6aを設けた。

再び有機保護層の第1層 6 a 上にディスク半径 4 5 m R 以内の部分のみに、有機保護層の第1層 6 a と同じフェノールノボラックエポキシアクリレート樹脂を塗布したのち、紫外線取射装置を邀過させて樹脂を硬化させ約20gmの有機保護層の第2層 6 b を設けた。

この光磁気ディスクの記録、消去、再生特性の 測定を行った。測定には、光磁気記録再生装置 (パルステック製DDU-1000)を用いた。 ディスクを3,600rpmで回転させ、半径 30mおよび60mの位置で記録、再生、消去を 行った。

信号の再生は、1.5mwのレーザーパワーで行った。記録時の最適レーザーパワーは、信号再生時の1次高周被と2次高周波の差が最大となる・値に決定した。信号周波数は、7.4MHz、duty33.3%とし、半径30mmRで

1 6

を第1表に示す。

第1表

サンプル No.	3 0 m R		6 0 = R	
	最適記録 パワー (mw)	C/N (dB)	最適記録 パワー (mw)	C/N (dB)
実施例1	5.0	50.0	9.0	54.0
比較例.1	4.0	47.0	9.0	53.0
実施例 2	5.5	51.0	9.0	55.0
比較例2	4.5	48.0	9.0	54.0

前記各サンプルについて、半径30mの最適記録パワーで半径60mにおいて記録し、そのC/Nを測定したところ、実施例1は52dB、実施例2は53dB、比較例1は49dB、比較例2は50dBであった。すなわち本発明により記録領域全体が同一低パワーのレーザー光により50dB以上の高C/Nの記録、再生ができることが確認された。

(発明の効果)

- 一本発明は、一内国部から外周部まで同一記録パワ
- ーで記録でき、再生のC/Nもよい光記録媒体を

提供することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は実施例1の光磁気記録媒体の積層構成の説明図、第2図は比較例1の光磁気記録媒体の積層構成の説明図である。

- 1:基板
- 2、4:透明誘電体層
- 3 a 、 3 b : 光磁気記録層
- 5:金属反射層
- 6 a 、 6 b 、 6 : 有機保護層

特許出願人 帝 人 株式会社 代理人 弁理士 白 井 重 隆

1 9

